

2016 International Conference on Solid State Device and Materials

参加報告書

西暦 2016年 9月 30日 作成

会議名	2016 International Conference on Solid State Device and materials (2016 SSDM)
期間	西暦 2016年 9月 26日 ~ 2016年 9月 29日
開催地	Tsukuba International Congress Center, Japan
所属機関	群馬大学大学院 理工学府 理工学専攻 小林研究室
フリカ ^ナ 氏名	ヒガシノ マサシ 東野 将史

1. 国際会議の概要

今回参加した 2016 SSDM (<http://www.ssdm.jp/index.html>)は、毎年日本で開催されている半導体デバイス分野に関する国際会議です。今年度で 48 回目を迎える歴史ある会議です。総参加者は、毎年 1,000 人を越えるそうで、アカデミックな専門家だけでなく、企業のエンジニアもおり、産学が共に注目している会議だと言う印象を受けました。会議の領域は、新規半導体デバイス、バイオセンサー、回路設計等の半導体デバイスに関する幅広い内容となっていました。日本での開催と言うこともあり、参加者はアジアが中心でしたが、ヨーロッパやアメリカからも多くの発表があり、規模が大きい会議だと感じました。

論文の採択率は 70%程で、182 件の研究発表があり、発表形式は、1)オーラル・プレゼンテーション、2)ショートプレゼンテーションとポスター発表の 2つの形式があります。発表では、ディスカッションが盛んに行われており、大変ハイレベルな研究を見ることができました。



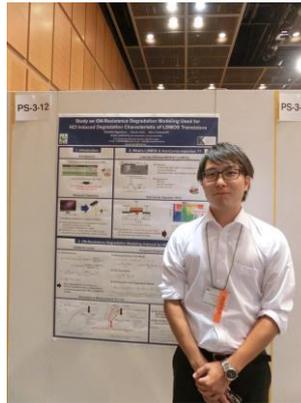
【つくば国際会議場】



【会場の様子】

2. 研究テーマと討論内容

私の研究テーマは、Laterally Diffused MOSFET (LDMOS)の hot-carrier-injection (HCI)による経時劣化を回路シミュレーターでシミュレーションを可能にするための劣化モデルの研究を行っています。本会議では、“Study on On-Resistance Degradation Modeling Used for HCI Induced Degradation Characteristic of LDMOS Transistors”という題目です。内容は、経時劣化をシミュレートするための関数開発と実測とシミュレーションの整合性について報告しました。発表形式は、ショートプレゼンテーション(3分)とポスターセッションでした。ポスターセッションの際には、多くの方々が質問をしに来て下さいました。特に、企業の方々からの質問が多くあり、産業界の方々に研究成果をアピールすることが出来たのは大きな成果だと思えます。



【プレゼンテーションの様子】

3. 国際会議に出席した成果（コミュニケーション・国際交流・感想）

本学会は、研究機関だけでなく産業界からも注目されていた事もあり、研究成果をアピールする場として大変有意義な時間であったと思えます。研究の根源は、未来の社会のためにあると、改めて実感しました。今回で3度目の国際会議での発表でしたが、やはり英語でのプレゼンテーションや質疑応答は難しかったです。しかし、少しずつではありますが、英語での発表も上達してきたと感じました。また、前回の台湾で開かれた国際会議(VLSI-DAT)で知り合った学生と再会することができ、学会を通じての友人ができたのも嬉しく思いました。

来年度から、社会人となりますが、今回の経験を活かして、世界から注目されるようなエンジニアになりたいと思いました。

最後に、このような実りのある国際学会への出席並びに研究をご支援して頂いたMoDeCH(株)の皆様、そして指導して下さいました青木均先生を初めとする皆様に深く感謝を申し上げます。